

СТРУКТУРА И БЛИЖНИЙ ПОРЯДОК В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ $Cd_xZn_{1-x}Te$

Г.С.Юрьев¹⁾, С.Ф.Маренкин²⁾, В.Н.Гуськов²⁾, А.М.Натаровский²⁾, С.Г.Никитенко¹⁾, К.В.Золотарев¹⁾

¹⁾Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирск

²⁾Институт общей и неорганической химии РАН, Москва

Твердые растворы (тв.р-ры) $Cd_xZn_{1-x}Te$ представляют интерес как материал для монокристалльных подложек при росте эпитаксиальных структур на основе $Cd_xHg_{1-x}Te$. Порошкообразные поликристаллические тв.р-ры были синтезированы непосредственным взаимодействием порошкообразных ZnTe и CdTe, на основе предварительно полученных монокристаллов c-ZnTe и c-CdTe.

На основе методов дифрактометрии (Д), дифракционного кино (ДК) с использованием синхротронного излучения изучена структура тв.р-ров $Cd_xZn_{1-x}Te$, ее изменение *in situ* при воздействии температуры 100-400°C, фазовый состав. Эксперименты проводились при энергии 2 ГэВ и токах 100-60мА ускорителя-накопителя В3ПП-3. Методом EXAFS изучена структура ближнего порядка тв.р-ров $Cd_xZn_{1-x}Te$ (определенны параметры ближнего порядка атомов Cd и Zn). Методом РФА осуществлен контроль стехиометрического состава, наличие примесей. Эксперименты проводились при энергии ускорителя-накопителя 2 ГэВ и токах 100-60мА.

На основании экспериментальных дифракционных картин (Д) порошкообразных образцов тв.р-ров сделан вывод о отклонении в области $x=0.9-0.7$ ат.% линейной зависимости параметра кристаллической решетки от состава x твердых растворов [$x=1$ ($a=6.4815\text{ \AA}$), $x=0.95$ ($a=6.4629\text{ \AA}$), $x=0.9$ ($a=6.4595\text{ \AA}$), $x=0.85$ ($a=6.4382\text{ \AA}$), $x=0.8$ ($a=6.4159\text{ \AA}$), $x=0.5$ ($a=6.2963\text{ \AA}$), $x=0.25$ ($a=6.1917\text{ \AA}$), $x=0.1$ ($a=6.1404\text{ \AA}$), $x=0$ ($a=6.10\text{ \AA}$)]. Установлено, что поликристаллический массивный образец CdTe(Zn) ($a=6.45\text{ \AA}$) имел (620)-текстуру с несколько увеличенным параметром ($a=6.4747\text{ \AA}$), что указывало на влияние дефектов (механической шлифовки, примеси) на величину параметра решетки. Массивные монокристаллические (111)CdTr(Zn) образцы [$x=0.97$ ($a=6.5123\text{ \AA}$), 0.96 ($a=6.5005\text{ \AA}$)], не имеющие примесей и разрушенного слоя на поверхности, имели несколько увеличенный параметр a по сравнению с параметром порошкообразного образца ($a=6.473 \pm 0.009\text{ \AA}$) со следами примеси. На основании покадровой регистрации (ДК) тв.р-ров (64 картины) как нагревания, так и охлаждения (64 картины) образцов до комнатной температуры, показано изменение их фазового состава.

EXAFS-спектры тв.р-ров регистрировались по схеме на "прохождение" (Cd K-спектры) и по схеме на "отражение" (Zn K-спектры). РФА спектры поглощения элементов тв.р-ров регистрировались по схеме на "прохождение" порошкообразных¹⁾ образцов и по схеме на "отражение" массивных (поликристаллического и монокристаллических) образцов при сканировании его поверхности.

Согласно установленным параметрам ближнего порядка в тв.р-рах в зависимости от x методом FXAFS установлено, что при $x \approx 0.7$ параметр кристаллической решетки отклоняется от параметра характерного для линейной зависимости. На основе РФА определено содержание примесей в порошкообразных (следы Co, Ni, Mn) и в массивных (поликристаллическом при сканировании его поверхности (следы Cu), в монокристаллических (отсутствие примесей) образцах. Монокристаллические и массивный поликристаллический образцы предоставлены О.А.Матвеевым, В.И.Терентьевым.

Работа выполнена по проекту INTAS N99-1456.

Юрьев Геннадий Степанович, yurjev@csd.inp.nsk.su

ИЯФ им.Будкера, пр.Лаврентьева, 11, корп.15.б, ком.6, 630090, Новосибирск